



产品特性 FEATURES

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ◆ 硅平面工艺结构 | Planar technique |
| ◆ 双向负阻性保护 | Bidirectional crowbar protection |
| ◆ 低漏电流 | Low leakage current |
| ◆ 低结电容 | Low junction capacitance |

最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项目 Parameter	脉冲峰值电流 Repetitive peak pulse current	绝缘电阻 Insulation Resistance	工作结温 Operation Junction Temperature	存储温度 Storage Temperature
符号 Symbol	I _{PP}	R	T _J	T _{STG}
单位 Unit	A	Ω	℃	℃
额定值 Absolute Ratings	800 (8/20μs)	1000M	-40~150	-40~150

芯片电特性 CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25℃)

参数 Parameter	测试条件 Tests Conditions	最小值 Min.	典型值 Tye.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V _{RM}	I _{RM} =2μA	190			V
最高限制电压 V _{BO}	100KV/s			260	V
通态电压 V _{TM}	I _T =1A			4	V
维持电流 I _H	10A, 10/1000μs	150			mA
极间电容 C	2V, 1MHz			120	pF

芯片信息 CHIP INFORMATION

圆片尺寸 Wafer Size	Φ4inch（100mm）	
芯片厚度 Chip Thickness	（190±10）μm	
芯片尺寸 Chip Size	A: 2.40mm×2.40mm	
金属 Metal	正面 Front	银 Ag
	背面 Back	银 Ag
键合区面积 Bond Area	B: 2.00mm×2.00mm	

附录 (Appendix)：修订记录 (Revision History)

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes

